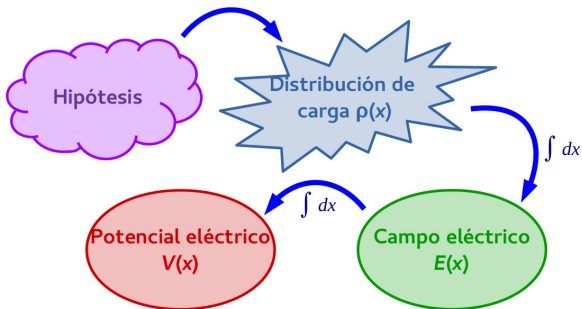


## Ejercicio: Juntura PN

# Enunciado

- ▶ Considere una juntura PN de silicio a 300K con  $N_A = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  y  $N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ .
  1. Para la condición de equilibrio térmico ( $V_R = 0 \text{ V}$ ), y bajo la aproximación de vaciamiento, realice los diagramas de
    - 1.1 concentración de dopantes  $N_A$  y  $N_D$
    - 1.2 concentración de portadores libres  $n_0$  y  $p_0$
    - 1.3 densidad de carga neta  $\rho$
    - 1.4 campo eléctrico
    - 1.5 potencial electrostático
  2. Repita el punto anterior para  $V_R = 5 \text{ V}$  y  $10 \text{ V}$ .
  3. Si el campo eléctrico máximo admitido es  $E_{MAX} = 5 \times 10^5 \text{ V/cm}$ , ¿Cuál es el máximo valor de  $V_R$  admisible?

# Metodología para la resolución



- ▶ Asumimos que las QNR's tienen neutralidad de carga
- ▶ Asumimos que las SCR están vacias de portadores (*región de vaciamiento*)
- ▶ Transición entre SCR y QNR's abrupta

# Descripción física

Silicio dopado con "Boro" (B)  
Tipo P

$N_a$ : Concentración de dopantes "aceptores" por unidad de volumen

Silicio dopado con "Fósforo" (P)  
Tipo N

$N_d$ : Concentración de dopantes "donores" por unidad de volumen

Figure: Esquema de materiales.

## Concentración de dopantes $N_A$ y $N_D$

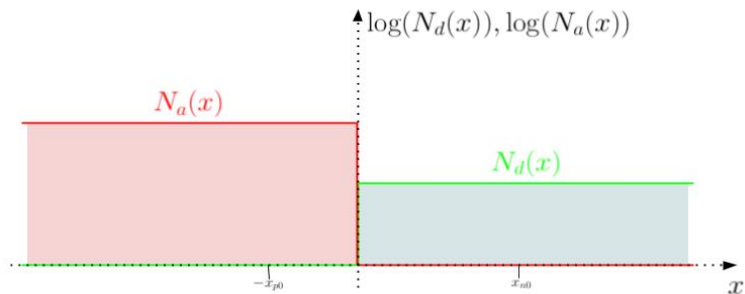


Figure: Concentración de dopantes donores ( $N_d$ ) y aceptores ( $N_a$ ).

# Concentración de portadores libres $n_0$ y $p_0$

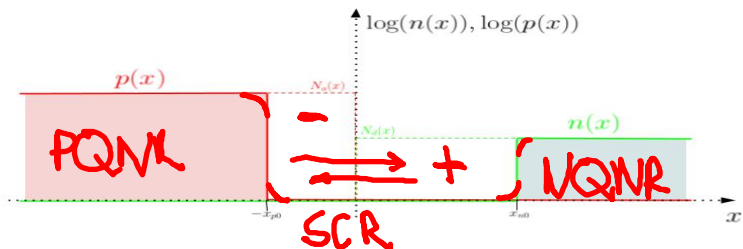


Figure: Diagrama de concentraciones de portadores libres en escala lineal.

	Hipótesis	$N_A$	$N_D$	$p_0$	$n_0$	$\rho(x)$
$x \leq x_{p0}$	HQN	$10^{19}$	0	$\sim N_A$ (QN)	$\frac{n^2}{N_A} \ll N_A$ (Min)	0 (QN)
$x_{p0} < x < 0$	VAC	$10^{19}$	0	$\sim 0$ (VAC)	$\sim 0$ (VAC)	$\sim -q \cdot N_A$
$0 \leq x < x_{n0}$	VAC	0	$10^{17}$	$\sim 0$ (VAC)	$\sim 0$ (VAC)	$\sim q \cdot N_D$
$x_{n0} \leq x$	HQN	0	$10^{17}$	$\frac{n^2}{N_D} \ll N_A$ (Min)	$\sim N_D$ (QN)	0 (QN)

# Concentración de portadores libres $n_0$ y $p_0$

Diff →

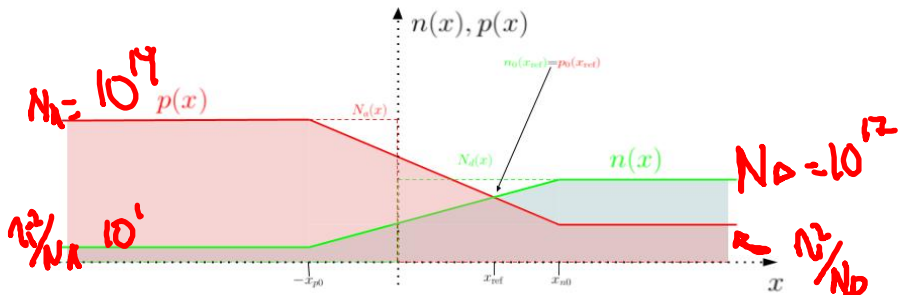
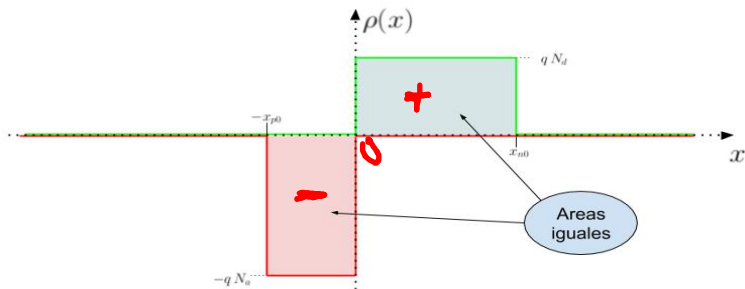


Figure: Concentración de dopantes donores ( $N_d$ ) y aceptores ( $N_a$ ) en escala semi-logarítmica.

# Densidad de carga neta $\rho(x)$



JORIFT

$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq x_{p0} \\ -qN_a = 1.6 \frac{\text{C}}{\text{cm}^3} & \text{si } x_{p0} < x < 0 \\ qN_d = 0.016 \frac{\text{C}}{\text{cm}^3} & \text{si } 0 \leq x < x_{n0} \\ 0 & \text{si } x_{n0} \leq x \end{cases}$$



# Campo eléctrico $E(x)$

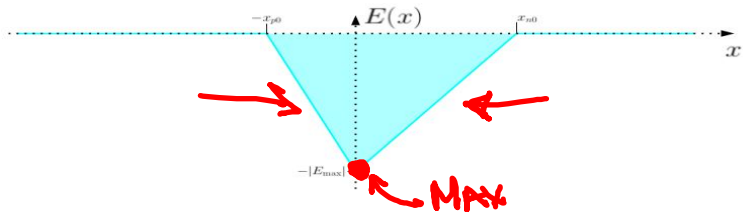


Figure: Campo eléctrico en la región de carga espacial (SCR).

$$E(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq x_{p0} \\ \frac{-qN_a}{\epsilon_s} (x + x_{p0}) & \text{si } x_{p0} < x < 0 \\ \frac{qN_d}{\epsilon_s} (x - x_{n0}) & \text{si } 0 \leq x < x_{n0} \\ 0 & \text{si } x_{n0} \leq x \end{cases}$$

$$\frac{-qN_a}{\epsilon_s} = -1.54 \cdot 10^{12} \frac{V}{cm^2}$$

$$\frac{qN_d}{\epsilon_s} = -15.4 \cdot 10^9 \frac{V}{cm^2}$$

# Potencial electrostático $\Phi(x)$

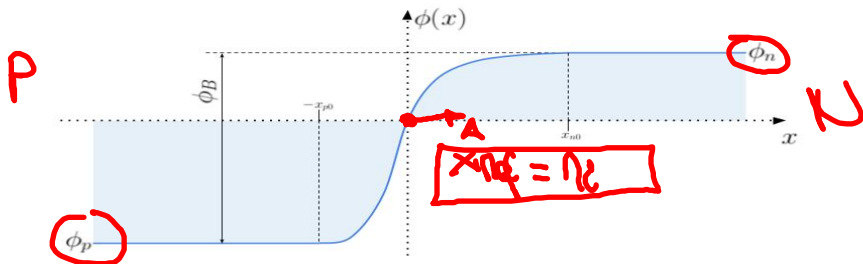


Figure: Potencial electrico en la juntura.

- ▶ en QNR-P:  $p_o = N_a \Rightarrow \phi_p = -\frac{kT}{q} \ln \frac{N_a}{n_i} = -0.535V$
- ▶ en QNR-N:  $n_o = N_d \Rightarrow \phi_n = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_d}{n_i} = 0.416V$

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi_p & \text{si } x \leq -x_{po} \\ \frac{qN_a}{2\epsilon_s}(x + x_{po})^2 & \text{si } -x_{po} < x < 0 \\ \phi_n - \frac{qN_d}{2\epsilon_s}(x - x_{no})^2 & \text{si } 0 \leq x < x_{no} \\ \phi_n & \text{si } x \geq x_{no} \end{cases}$$

## ¿Dónde termina la SCR?

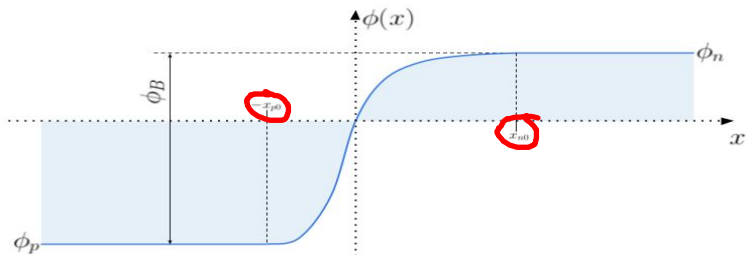


Figure: Potencial electrico en la juntura.

$$\phi_B = \phi_n - \phi_p = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} = 0.950V$$

$$x_{no} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s \phi_B N_a}{q(N_a + N_d)N_d}} = 1.1 \cdot 10^{-5} [cm]$$

$$x_{po} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s \phi_B N_d}{q(N_a + N_d)N_a}} = 1.1 \cdot 10^{-7} [cm]$$

# Casos de interés según su relación entre concentraciones

Tres casos de interés:

- ▶ Junta simétrica:  $N_a = N_d \Rightarrow x_{po} = x_{no}$
- ▶ Junta asimétrica:  $N_a > N_d \Rightarrow x_{po} < x_{no}$
- ▶ Junta muy asimétrica:  
ej. p<sup>+</sup>n junta:  $N_a \gg N_d$

$$x_{po} \ll x_{no} \simeq x_{do} \simeq \sqrt{\frac{2\epsilon_s \phi_B}{q N_d}} \propto \frac{1}{\sqrt{N_d}}$$
$$|E_o| \simeq \sqrt{\frac{2q\phi_B N_d}{\epsilon_s}} \propto \sqrt{N_d}$$

El lado poco dopado controla la electrostática de la junta PN.

- ▶ Herramienta para jugar:  
<https://www.desmos.com/calculator/t5tyltuppv>

## Juntura con polarización

- La formulación analítica de la electrostática de la juntura PN polarizada es idéntica a la del equilibrio térmico, solo que:

$$V < 0$$

$$V > 0 \rightarrow D$$

$$\phi_B \rightarrow \phi_B - V$$

$$x_n(V) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\phi_B - V)N_a}{q(N_a + N_d)N_d}} \downarrow$$

$$x_p(V) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\phi_B - V)N_d}{q(N_a + N_d)N_a}} \downarrow$$

$$x_d(V) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(\phi_B - V)(N_a + N_d)}{qN_aN_d}} \downarrow$$

$$|E|(V) = \sqrt{\frac{2q(\phi_B - V)N_aN_d}{\epsilon_s(N_a + N_d)}} \downarrow$$

## Juntura con polarización

Resumen de resultados para el punto 2:

$V_R$	0	-5	-10	[V]
$\phi_b - V_R$	9.53E-01	5.95E+00	1.10E+01	[V]
$x_n$	1.11E-05	2.76E-05	3.75E-05	[cm]
$x_p$	1.11E-07	2.76E-07	3.75E-07	[cm]
$x_d$	1.12E-05	2.79E-05	3.78E-05	[cm]
$E_0$	1.71E+05	4.27E+05	5.79E+05	[V/cm]

Punto 3:

Sabiendo que el campo eléctrico se puede reescribir como:

$$|E|(V) = |E_0| \sqrt{1 - \frac{V}{\phi_B}} \Rightarrow V_R = \phi_b \left(1 - \left(\frac{|E|}{|E_0|}\right)^2\right) = -7.2[V]$$